Catalogo prodotti

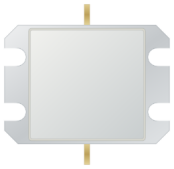
Transistor di potenza RF

I transistor di potenza RF trasformano polarizzazione e pilotaggio RF in potenza di uscita all'interno di uno stadio amplificatore. Sono usati in catene di trasmissione, moduli pulsati o CW, apparecchiature RF industriali e banchi di prova ad alta potenza.



Prodotti: 11

Revisione: 9 · Data revisione: 2026-11-11



LCT-5700-7100-PS51T

5700–7100 MHz GaN Transistor di potenza con adattamento interno — PSAT 51 dBm (tipico)

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (tipico); Guadagno di potenza 11 dB (tipico); PAE 45 % (tipico).

Frequenza operativa: Simbolo: f; Minimo: 5700; Massimo: 7100; Valore: 5700–7100; Unità: MHz

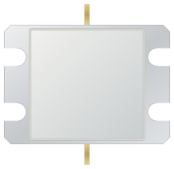
Potenza di uscita satura: Minimo: 50.5; Tipico: 51; Unità: dBm

Guadagno di potenza: Minimo: 10.5; Tipico: 11; Unità: dB

Efficienza di potenza aggiunta: Minimo: 40; Tipico: 45; Unità: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCT-2700-3500-PS56p5T

2700–3500 MHz GaN Transistor di potenza con adattamento interno — PSAT 56.5 dBm (tipico)

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (tipico); Guadagno di potenza 13.5 dB (tipico); PAE 55 % (tipico).

Frequenza operativa: Simbolo: f; Minimo: 2700; Massimo: 3500; Valore: 2700–3500; Unità: MHz

Potenza di uscita satura: Minimo: 56; Tipico: 56.5; Unità: dBm

Guadagno di potenza: Minimo: 13; Tipico: 13.5; Unità: dB

Efficienza di potenza aggiunta: Minimo: 50; Tipico: 55; Unità: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 300 µs; D = 10%

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCT-5300-5900-PS56p5T

5300–5900 MHz GaN Transistor di potenza con adattamento interno — PSAT 56.5 dBm (tipico)

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (tipico); Guadagno di potenza 12.5 dB (tipico); PAE 45 % (tipico).

Frequenza operativa: Simbolo: f; Minimo: 5300; Massimo: 5900; Valore: 5300–5900; Unità: MHz

Potenza di uscita satura: Minimo: 56; Tipico: 56.5; Unità: dBm

Guadagno di potenza: Minimo: 12; Tipico: 12.5; Unità: dB

Efficienza di potenza aggiunta: Minimo: 40; Tipico: 45; Unità: %

TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1%

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCT-2700-3900-PS48p5T

2700–3900 MHz GaN Transistor di potenza con adattamento interno — PSAT 48.5 dBm (tipico)

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (tipico); Guadagno di potenza 12.5 dB (tipico); PAE 50 % (tipico).

Frequenza operativa: Simbolo: f; Minimo: 2700; Massimo: 3900; Valore: 2700–3900; Unità: MHz

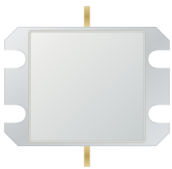
Potenza di uscita satura: Minimo: 48; Tipico: 48.5; Unità: dBm

Guadagno di potenza: Minimo: 12; Tipico: 12.5; Unità: dB

Efficienza di potenza aggiunta: Minimo: 45; Tipico: 50; Unità: %

TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCT-2700-3500-PS53p5T

2700–3500 MHz GaN Transistor di potenza con adattamento interno — PSAT 53.5 dBm (tipico)

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (tipico); Guadagno di potenza 13.5 dB (tipico); PAE 65 % (tipico).

Frequenza operativa: Simbolo: f; Minimo: 2700; Massimo: 3500; Valore: 2700–3500; Unità: MHz

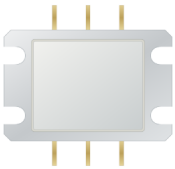
Potenza di uscita satura: Minimo: 53; Tipico: 53.5; Unità: dBm

Guadagno di potenza: Minimo: 13; Tipico: 13.5; Unità: dB

Efficienza di potenza aggiunta: Minimo: 60; Tipico: 65; Unità: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-4, -2] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCT-2300-3900-PS50T

2300–3900 MHz GaN Transistor di potenza con adattamento interno — PSAT 50 dBm (tipico)

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (tipico); Guadagno di potenza 12 dB (tipico); PAE 50 % (tipico).

Frequenza operativa: Simbolo: f; Minimo: 2300; Massimo: 3900; Valore: 2300–3900; Unità: MHz

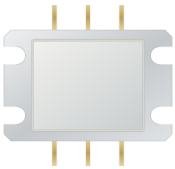
Potenza di uscita satura: Minimo: 49; Tipico: 50; Unità: dBm

Guadagno di potenza: Minimo: 11; Tipico: 12; Unità: dB

Efficienza di potenza aggiunta: Minimo: 45; Tipico: 50; Unità: %

TA = +25 °C; VGS ∈ [-4, -2] V; VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCT-2600-3700-PS49T

2600–3700 MHz GaN Transistor di potenza con adattamento interno — PSAT 49 dBm (tipico)

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (tipico); Guadagno di potenza 13 dB (tipico); PAE 50 % (tipico).

Frequenza operativa: Simbolo: f; Minimo: 2600; Massimo: 3700; Valore: 2600–3700; Unità: MHz

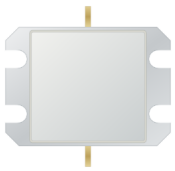
Potenza di uscita satura: Minimo: 48; Tipico: 49; Unità: dBm

Guadagno di potenza: Minimo: 12; Tipico: 13; Unità: dB

Efficienza di potenza aggiunta: Minimo: 45; Tipico: 50; Unità: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCT-8500-9600-PS51T

8500–9600 MHz GaN Transistor di potenza con adattamento interno — PSAT 51 dBm (tipico)

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (tipico); Guadagno di potenza 9 dB (tipico); PAE 38 % (tipico).

Frequenza operativa: Simbolo: f; Minimo: 8500; Massimo: 9600; Valore: 8500–9600; Unità: MHz

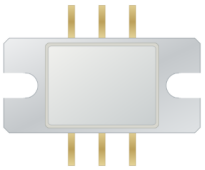
Potenza di uscita satura: Minimo: 50; Tipico: 51; Unità: dBm

Guadagno di potenza: Minimo: 8; Tipico: 9; Unità: dB

Efficienza di potenza aggiunta: Tipico: 38; Unità: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCT-2000-6000-PO45p51T

2000–6000 MHz GaN Transistor di potenza con adattamento interno — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (tipico)

2000–6000 MHz; Potenza di uscita di riferimento 45.51 dBm (tipico); Guadagno di potenza 19.51 dB (tipico); Efficienza di drain 39.82 % (tipico) @ 6000 MHz.

Frequenza operativa: Simbolo: f; Minimo: 2000; Massimo: 6000; Valore: 2000–6000; Unità: MHz

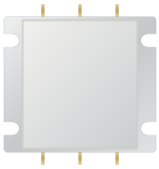
Potenza di uscita di riferimento: Tipico: 45.51; Unità: dBm; Note: f = 6000 MHz

Guadagno di potenza: Tipico: 19.51; Unità: dB; Note: f = 6000 MHz

Efficienza di drain: Simbolo: ηD; Tipico: 39.82; Unità: %; Note: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCT-700-6200-PS49T

700–6200 MHz GaN Transistor di potenza con adattamento interno — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (tipico)

700–6200 MHz; Potenza di uscita satura 49 dBm (tipico); Guadagno di potenza 7 dB (tipico); Efficienza di drain 35 % (tipico) @ 6000 MHz.

Frequenza operativa: Simbolo: f; Minimo: 700; Massimo: 6200; Valore: 700–6200; Unità: MHz

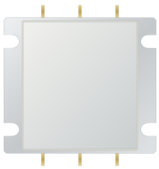
Potenza di uscita satura: Simbolo: Psat; Tipico: 49; Unità: dBm; Note: f = 6000 MHz

Guadagno di potenza: Tipico: 7; Unità: dB; Note: f = 6000 MHz

Efficienza di drain: Simbolo: ηD; Tipico: 35; Unità: %; Note: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto



LCT-2000-6200-PO50p1T

2000–6200 MHz GaN Transistor di potenza con adattamento interno — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (tipico)

2000–6200 MHz; Potenza di uscita di riferimento 50.1 dBm (tipico); Guadagno di potenza 8.6 dB (tipico); Efficienza di drain 52.4 % (tipico) @ 6000 MHz.

Frequenza operativa: Simbolo: f; Minimo: 2000; Massimo: 6200; Valore: 2000–6200; Unità: MHz

Potenza di uscita di riferimento: Tipico: 50.1; Unità: dBm; Note: f = 6000 MHz

Guadagno di potenza: Tipico: 8.6; Unità: dB; Note: f = 6000 MHz

Efficienza di drain: Simbolo: ηD; Tipico: 52.4; Unità: %; Note: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

Dettagli del prodotto Scheda tecnica del prodotto

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.